

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

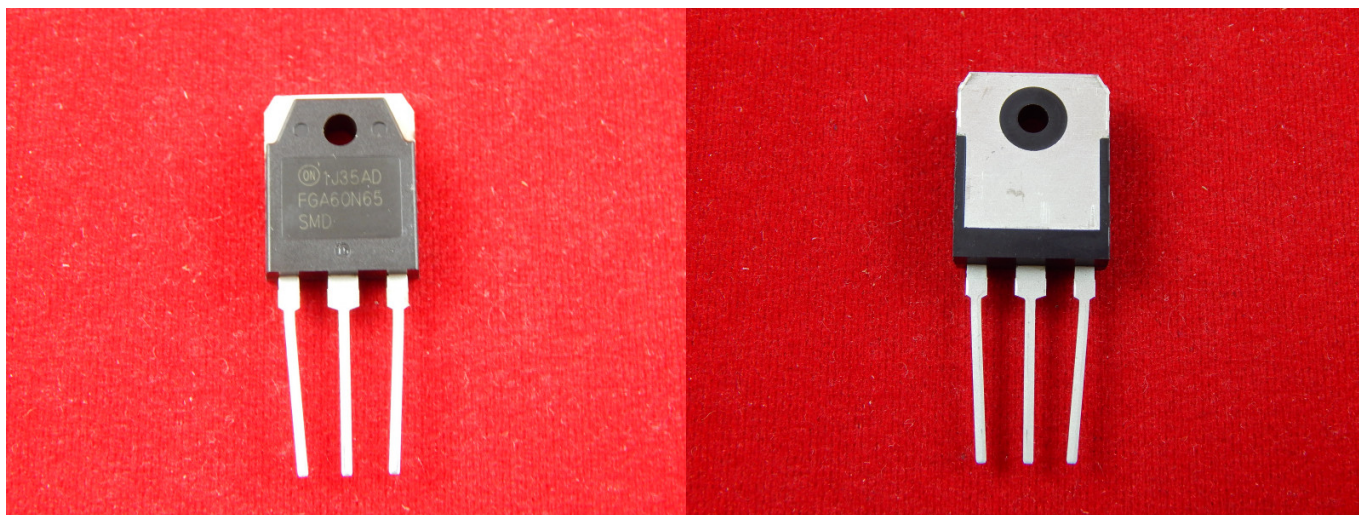
E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 15806**

**Цена в прайсе: 1265 тг.**

**FGA60N65SMD, биполярный транзистор IGBT, 650В, 120А, 600Вт**



Транзистор – полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой (база) подаётся слабый (управляющий ток).

Биполярный транзистор — трёхэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов. В полупроводниковой структуре сформированы два р-п-перехода, перенос заряда через которые осуществляется носителями двух полярностей — электронами и дырками. Именно поэтому прибор получил название биполярный.

#### **Спецификация:**

- Наименование: FGA60N65SMD;
- Тип управляющего канала: N-Channel;
- Максимальная рассеиваемая мощность: 600 W;
- Предельно-допустимое напряжение коллектор-эмиттер: 650 V;
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: 2.5 V;
- Максимально допустимое напряжение эмиттер-затвор: 20 A;
- Максимальный постоянный ток коллектора: 120 A;
- Максимальная температура перехода: 175°C;
- Время нарастания: 47 нс;
- Емкость коллектор: 270 pF;
- Рабочая температура: от -55°C до +175°C;
- Корпус: TO-3PN.

#### **Структурная схема:**

